

关键指标

- 频率: 8~12GHz
- 增益: 26 dB
- 噪声系数: 1.1dB
- 1dB 压缩点输出功率: 10dBm
- 电压/电流: +5V/30mA
- 芯片尺寸: 1.8mm×0.85mm×0.1mm

产品简介

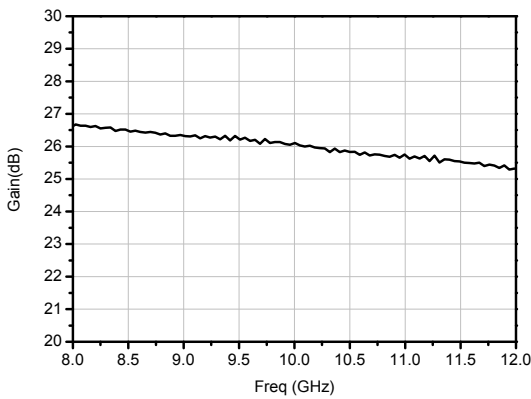
HG115FN-1 是一款 8~12GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 26dB, 噪声系数为 1.1dB, 1dB 压缩点输出功率为 10dBm。

电性能 (TA=25°C, Vdd=+5V)

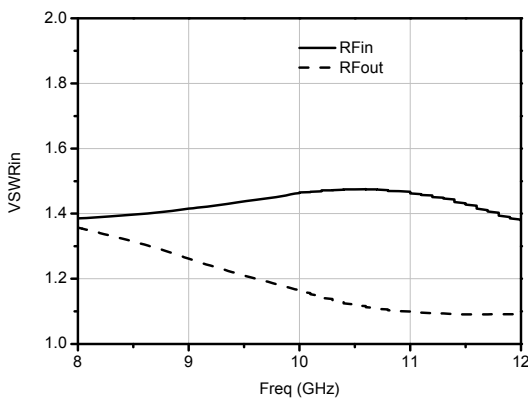
指标	最小值	典型值	最大值
频率(MHz)	8~12		
增益(dB)	—	26	—
增益平坦度(dB)	—	±0.6	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.3	—
噪声系数(dB)	—	1.1	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	10	—
静态电流 (mA)	—	30	—

典型测试曲线

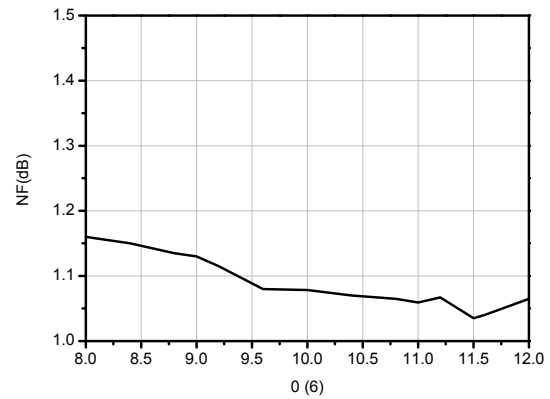
增益



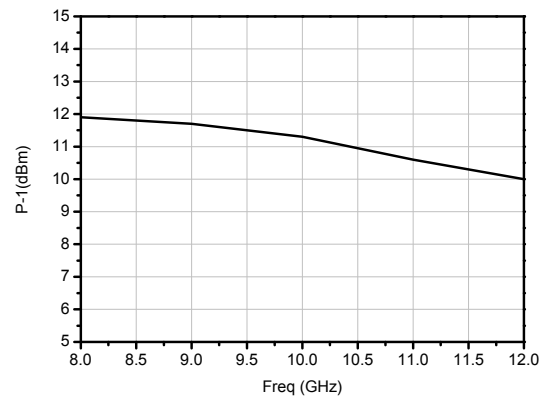
驻波



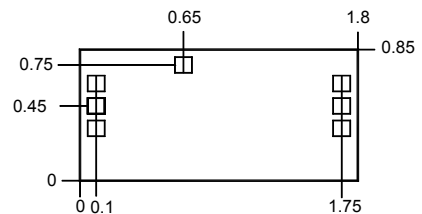
噪声系数



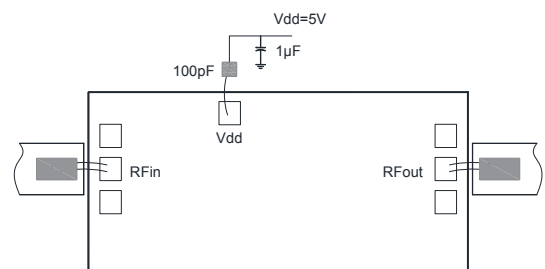
1dB 压缩点输出功率



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。